

0.5微米氮化硼

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 0.5微米氮化硼 |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址） |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

产品详情

0.5微米氮化硼

石墨烯材料（graphene）和六方氮化硼（h-BN）构造类似但电学特性迥然不同。因为石墨烯材料/六方氮化硼平面图异质结在基础研究和元器件探寻层面具备关键发展潜力，因此深受学界关心。graphene/h-BN平面图异质结的制取一般选用先后堆积石墨烯材料和h-BN，或是反过来顺序来完成，因为事后塑料薄膜成分过冷操纵艰难及其生长发育全过程中反映汽体非常容易对前序塑料薄膜造成毁坏，因此现阶段参考文献汇报graphene/h-BN平面图异质结的品质不尽人意。中科院上海微系统所信息内容新型功能材料国家重点实验室的卢光远、吴天如等根据铜镍合金衬底生长发育高品质h-BN和石墨烯薄膜的研究基础，根据先堆积h-BN单晶体后生长发育石墨烯材料，取得成功制取了高品质石墨烯材料/h-BN平面图异质结。

因为铜镍合金上石墨烯材料生长发育速率很快，较短的石墨烯材料堆积时间减少了对石墨烯薄膜生长发育全过程中对h-BN塑料薄膜的毁坏。另外因为铜镍合金出色的催化反应工作能力，在提升氮化硼单晶体结晶体品质的另外清除了石墨烯材料的任意形核，促使石墨烯材料晶畴只在三角状h-BN单晶体畴的夹角处成分过冷并顺着h-BN边趋向生长发育。研究组与英国莱斯大学Jun Lou专家教授等团队协作，运用协作塑造博士生方案，在高品质石墨烯材料/h-BN平面图异质结的基本上，以石墨烯材料做为触碰电极，h-BN做为绝缘层衬底，制取了WSe₂/MoS₂二维光电探测器，认证了石墨烯材料/h-BN平面图异质结的品质和电学特性，为根据该异质结原材料服务平台进行基础研究和二维逻辑性集成电路芯片运用探寻出示了基本。